

初始时写使能端 wen 为高电平,在 40ns 时,写使能端 wen 置为低电平并保持,向寄存器 D0中写入 a0h,其后的第一个时钟上升沿(50ns)时读出寄存器 D0=a0h。

在 80ns 时,向寄存器 D1 中写入 a1h,读出寄存器 D0=a0h;

在 120ns 时,向寄存器 D2 中写入 a2h,读出寄存器 D1=a1h;

在 160ns 时,向寄存器 D3 中写入 a3h,读出寄存器 D2=a2h;

在 200ns 时,向寄存器 D4 中写入 a4h,读出寄存器 D3=a3h;

在 240ns 时,向寄存器 D5 中写入 a5h,读出寄存器 D4=a4h;

在 280ns 时,向寄存器 D6 中写入 a6h,读出寄存器 D5=a5h;

在 320ns 时,向寄存器 D7 中写入 a7h,读出寄存器 D6=a6h;

在 360ns 时,读出寄存器 D7=a7h。

在 400ns 时,将写使能端 wen 置无效,向寄存器 D7 中写入 b7h,寄存器内容保持,读出寄存器 D7=a7h;

在 440ns 时, 置清零端 clrn 为低电平, 进行清零读出 D7=00h。